

イト間の反強磁性的相互作用であるのに対して、 J_R は酸素スピンの銅スピンに対する反強磁性的分極を媒介とする、銅サイト間に生じる強磁性的相互作用である。酸素バンドのドーピングによるこれらの変化が J_S や J_R の δ 依存性を決めている。これらの結果は、 J_S や J_R の δ 依存性が大きいので、今後の磁気相や超伝導相の研究に考慮されなければならないことを示している。

4. 逆磁場配位 (FRC) プラズマの傾角モード安定性

菅 野 龍太郎

FRC の配位そのものを壊してしまう内部傾角モード不安定性は、最近、最も関心がもたれている研究テーマの1つである。この不安定性は、プラズマ電流が反磁性であるために、それによって、誘導される自己磁場が、外部から印加された磁場の向きと逆になることに起因する。理想 MHD 理論によれば、FRC は、モードの成長時間 $1 \sim 5 \mu\text{sec}$ 程度で崩壊すると予想されるが、実験では、その寿命は $100 \sim 450 \mu\text{sec}$ 程度で、予想よりも安定であることがわかっている。

Steinhauer と Ishida [1] は、ジャイロ粘性の効果を考慮することにより、従来の安定性理論を大幅に改良し、安定-不安定境界のスケーリングを求めることを容易にした。この SI 理論の弱点は、現在の実験における偏長度 $E = 3 \sim 10$ の領域の安定-不安定性境界が十分に明確にできなかったことである。

本論文では、FRC における内部傾角モードの安定性について考察することにし、その安定性解析は、SI 理論にしたがうことにした。

以下のような結果を得た。

1. SI 理論の弱点を改良し、 $E = 3 \sim 10$ の領域の安定-不安定境界を明確にした。
2. 安定-不安定境界のスケーリング (s/E) について、Tuszewski et al. [2] の最近の実験とほぼ一致する結果を得た。(ただし、 $s \sim a / \langle f_i \rangle$ 、 $E = l_s / 2a$; a は FRC のセパトロリクス半径、 l_s は、セパトロリクスの長さ、 $\langle f_i \rangle$ は、実効的なイオンのラーモア半径。)
3. 磁場の弱い 0-point 付近の面積を広げると、傾角モードは、より安定化するということがわかった。

参考文献:

- [1] L. C. Steinhauer, A. Ishida, Phys. Fluids B 2 (1990) 2422
- [2] M. Tuszewski, D. Barnes, J. Cobb, R. Crien, D. Rej, D. Taggart, R. Siemon, B. Wright, LANL Report LA-UR-90-2704, submitted to PRL.

5. 非結晶 $\text{Ge}_x\text{S}_{1-x}$ 及び $\text{Ge}_x\text{Se}_{1-x}$ 化合物の構造

笛 木 信 宏

金属にしる半導体にしる、アモルファスと名のつく物質材料の研究が今日のように多くの人々の関心を爆発的に集めだしたのはほんのここ数年のことである。これらのアモルファス物質は対応する結晶と比較して材料特性という点で優れた面を持つことがまず注目され、応用、実用化が先行し、基礎

的な研究は後を追う形となった。

そこで、本研究では、特に構造面に着目し、 $\text{Ge}_x\text{S}_{1-x}$ 、 $\text{Ge}_x\text{Se}_{1-x}$ 系化合物に対して X 線回折実験を試み、その構造の検討を行った。試料は、S に対しては $x=0.1\sim0.4$ 、Se に対しては $x=0\sim0.4$ の範囲で 0.05 おきに、それぞれ 7 組成と 9 組成作成した。

X 線回折実験は、X 線源に $\text{MoK}\alpha$ 線を用い、step scan 法で $2\theta = 4^\circ\sim150^\circ$ まで測定した。測定強度曲線より得られる構造因子をフーリエ変換することで二体分布関数 $g(r)$ を求めた。

その結果、Ge-S、Ge-Se とともに $2\theta = 7^\circ$ 付近にピークがみられたが、これはそれぞれ対応する GeS_2 、 GeSe_2 結晶の最強反射に対応しており、 $g(r)$ の結果からも、アモルファスの構造のモデルとしては、対応する結晶の構造を基本にしていると推定できる。

また、アモルファス試料中で、Ge 及びカルコゲン原子はどのような位置関係にあるのかは total $g(r)$ からだけでは議論できないので、本研究では、狭い組成領域では部分構造因子は変化をしないという仮定の下で三元連立方程式を解くことによって部分構造因子を導出し、その様子を調べる。

○立命館大学大学院理工学研究科物理学専攻

- | | |
|--|-------|
| 1. Electron Emission from Al Surface by Ar Ion Bombardment | 小川 博史 |
| 2. 水酸化ルビジウム単結晶の X 線回折法による研究 | 神尾 浩 |
| 3. アンチモン結晶化膜における銅の拡散による金属間化合物 (Cu_2Sb) 結晶の成長 | 古島 聡 |

1. Electron Emission from Al Surface by Ar Ion Bombardment

小 川 博 史

The angular distribution of the energy-resolved secondary electrons emitted from Al surface has been measured by bombarding with 15, 10, and 5keV Ar ions using retarding-potential method. For this purpose, the experimental apparatus was specially designed and fabricated. In this experiment, it was revealed that the intensity of the secondary electrons decreases as the emission angle increases and the energy of the projectiles decreases in spite of conditional